



锗(Ge)

用途：制作半导体器件，红外光学器件，及太阳能电池衬底等材料。

主要性能参数			
生长方法	提拉法		
晶体结构	立方		
晶格常数	a=5.65754 Å		
密度	5.323g/cm ³		
熔点	937.4°C		
掺杂物质	不掺杂	掺 Sb	掺 Ga
类型	/	N	P
电阻率	>35Ωcm	0.05~35 Ωcm	0.05~35 Ωcm
EPD	<1×10 ⁴ /cm ²	<1×10 ⁴ /cm ²	<1×10 ⁴ /cm ²
尺寸	10x3, 10x5, 10x10, 15x15, , 20x15, 20x20,		
	dia2” x 0.5mm dia2” x 0.5mm 15 x 15 mm		
厚度	0.5mm, 1.0mm		
抛光	单面或双面		
晶向	<100>、<110>、<111>、±0.5°		
晶面定向精度:	±0.5°		
边缘定向精度:	2° (特殊要求可达 1°以内)		
斜切晶片	可按特定需求，加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜（倾斜角 1°—45°）的晶片		
Ra:	≤5Å (5 μm×5 μm)		
包装	100 级洁净袋，1000 级超净室		